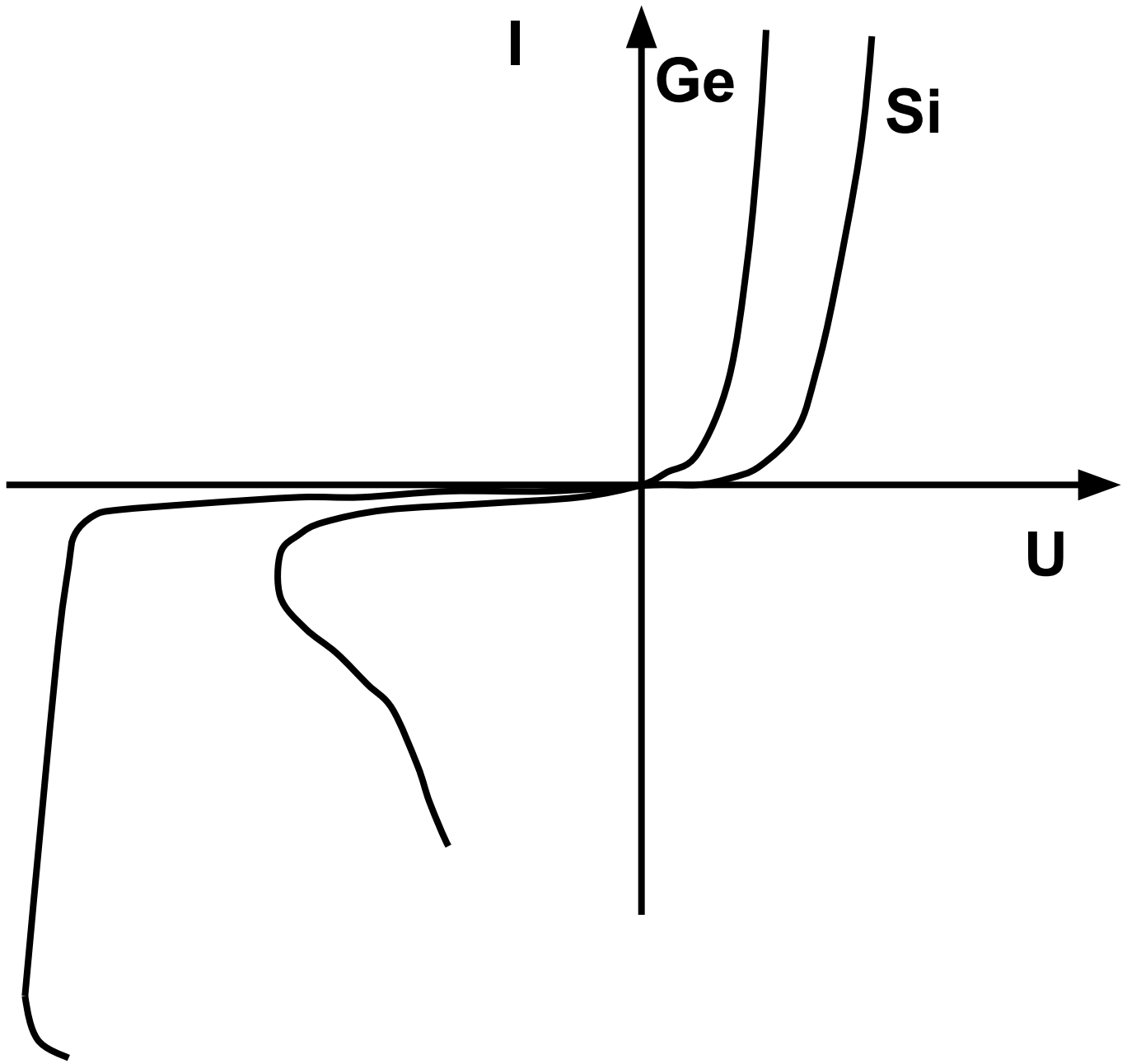
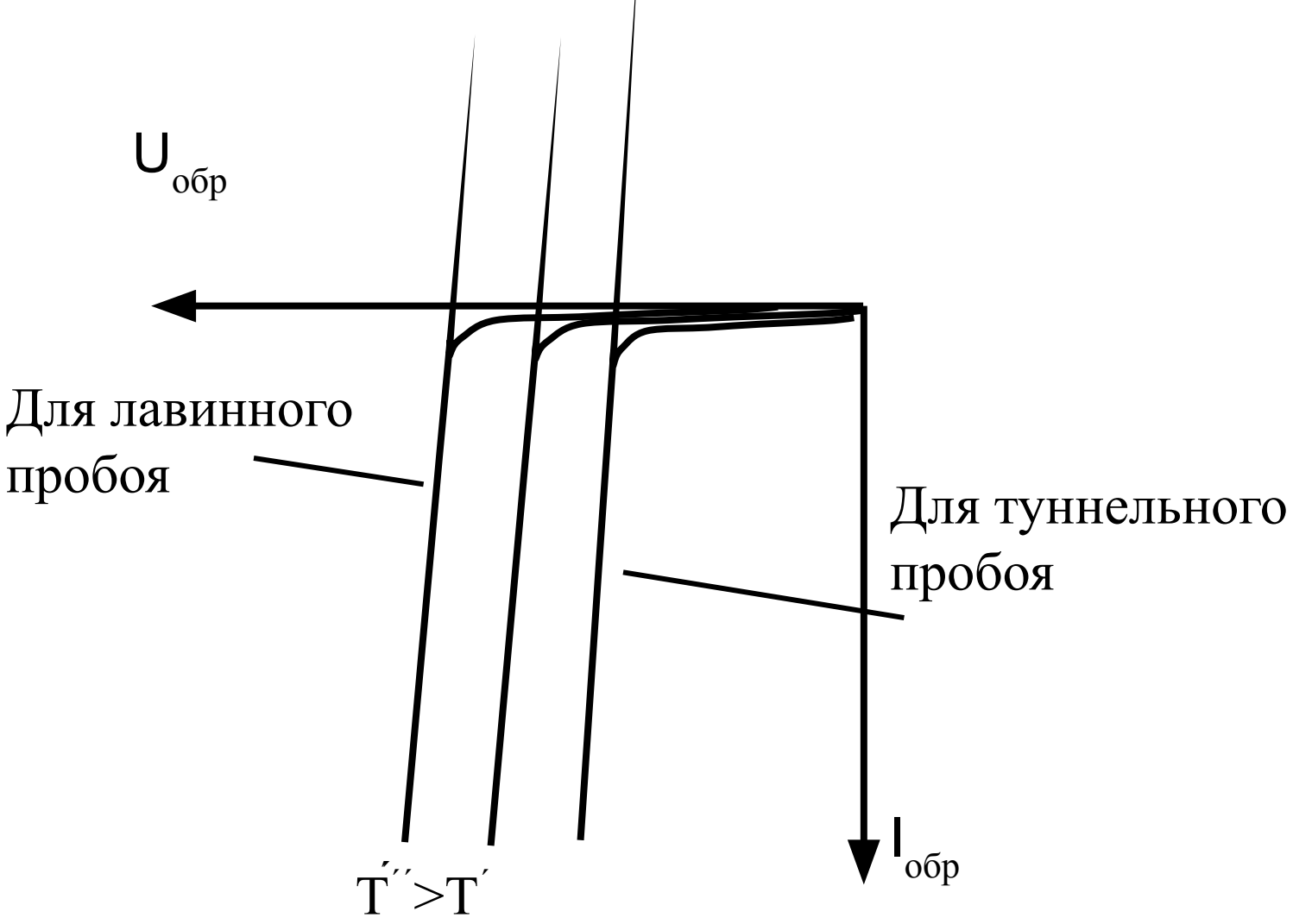
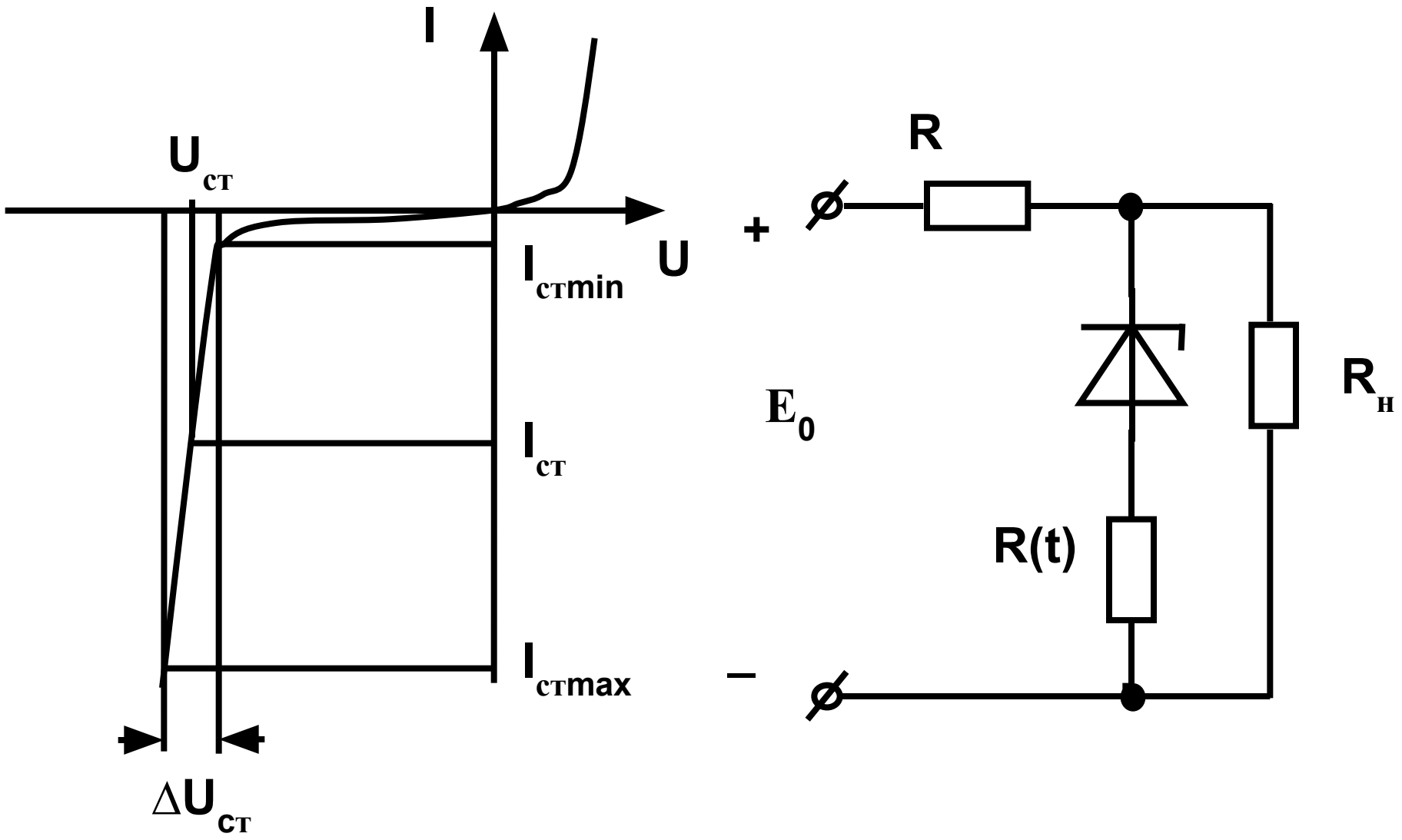
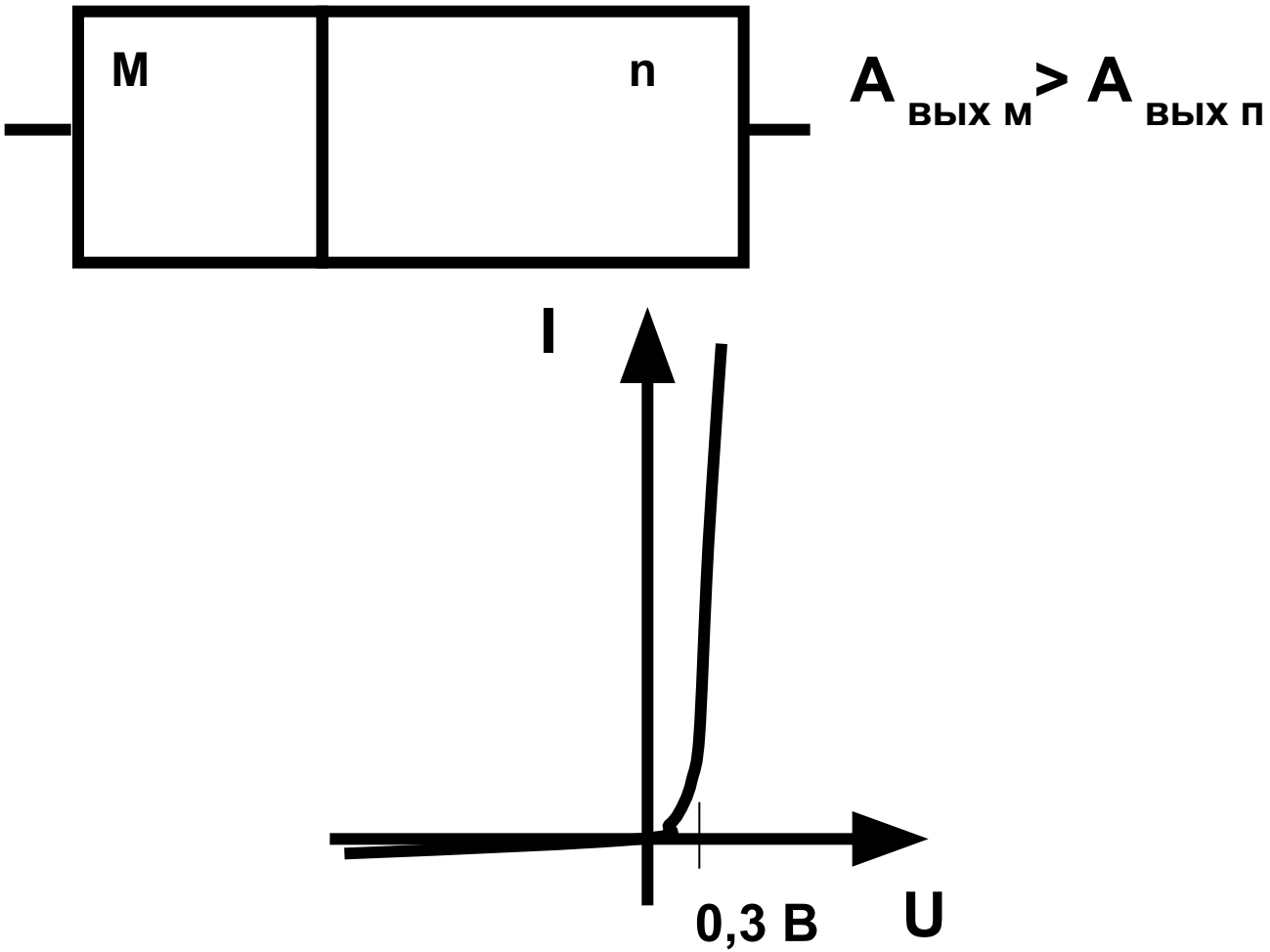
Лекция № 3.2.

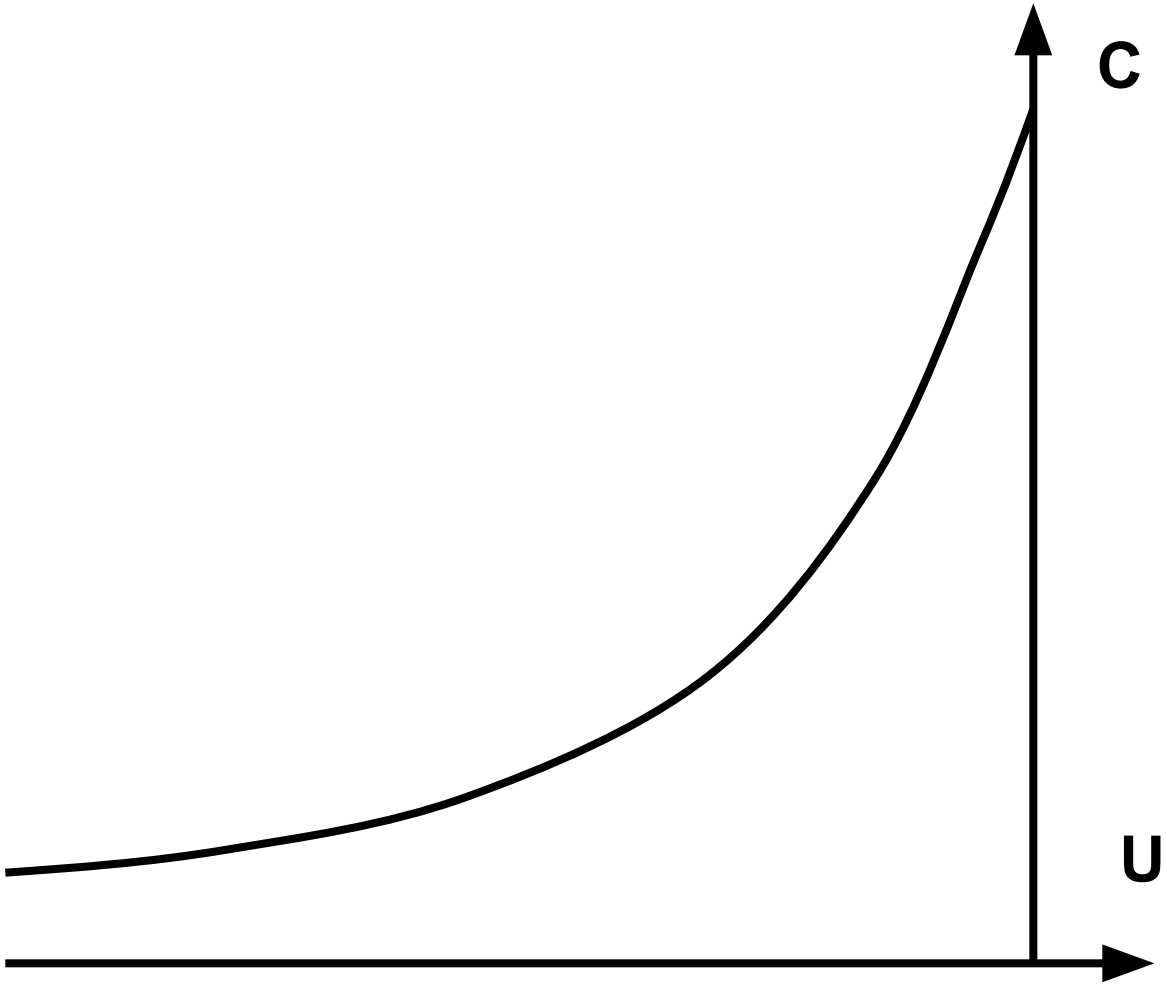
Разновидности и особенности полупроводниковых диодов

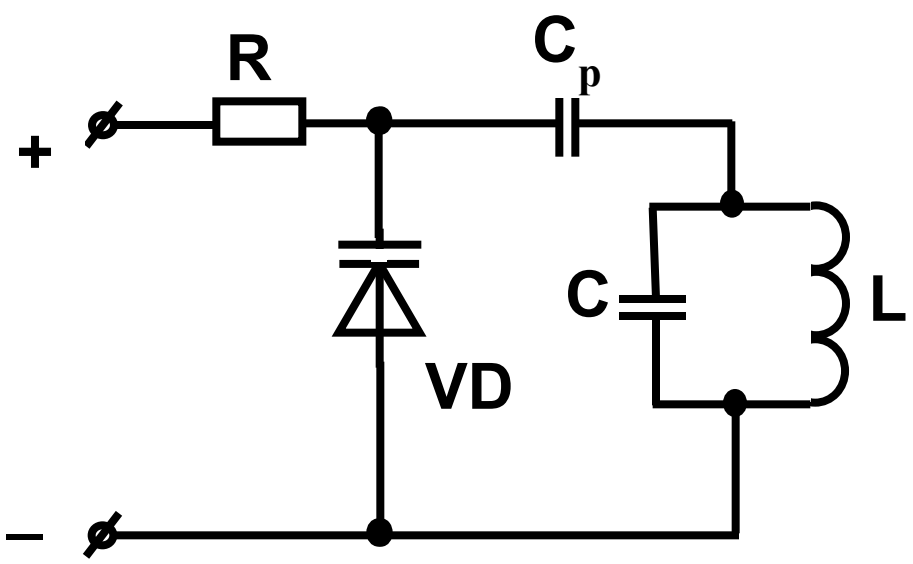

I
Ge
Si
U

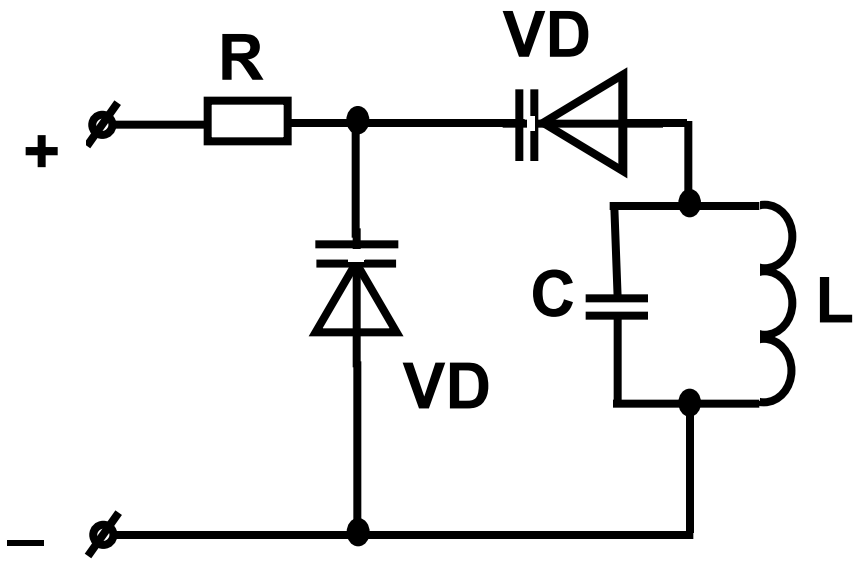

U обр
Для лавинного пробоя
Для туннельного пробоя
I обр
T´´>T´

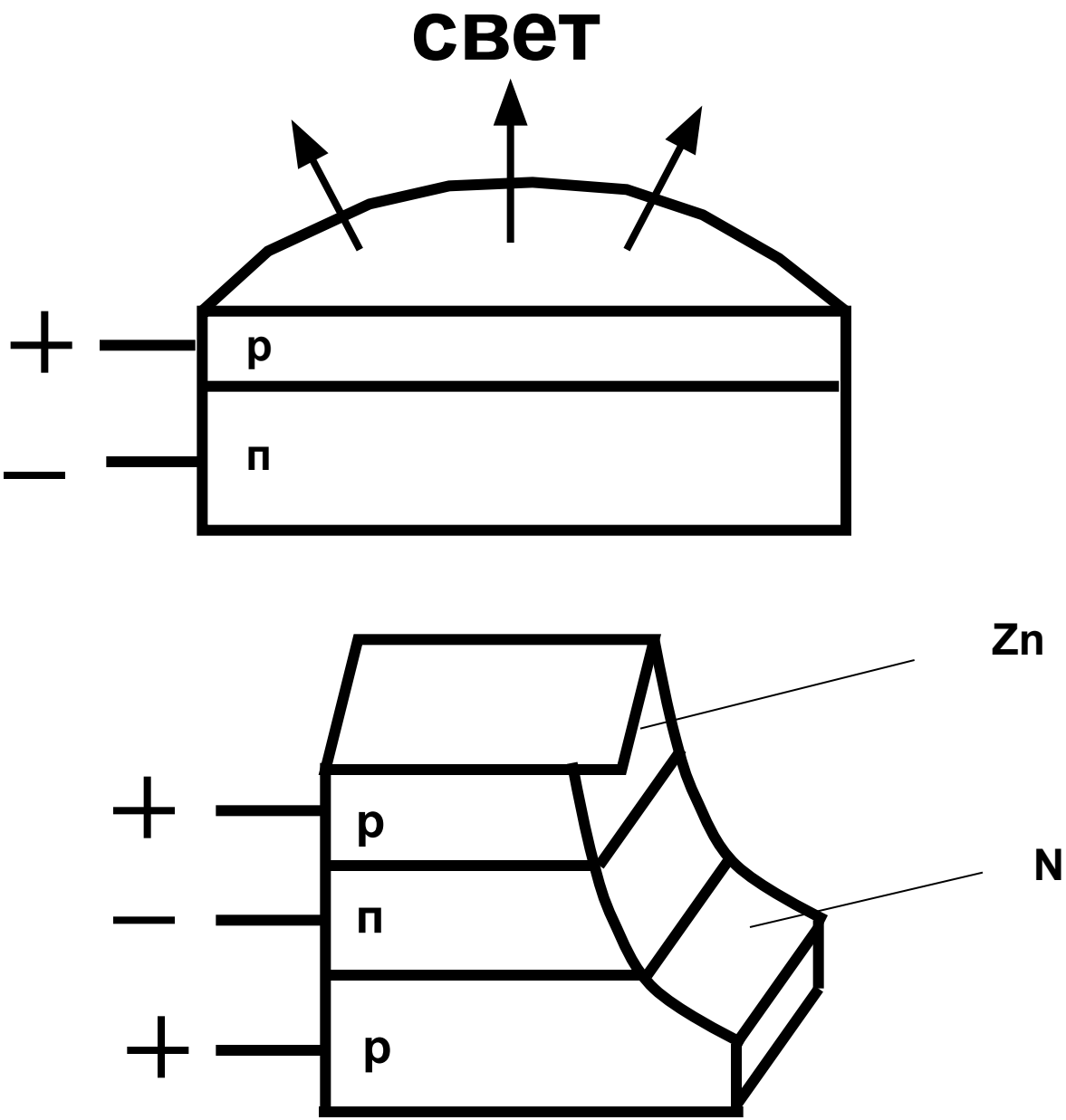

I
U
$U_{ст}$
$I_{стmin}$
$I_{ст}$
$I_{стmax}$
$\Delta U_{ст}$
R
+
E_0
R(t)
$R_н$
–


M
n
$A_{вых\ м} > A_{вых\ п}$
I
0,3 В
U


C
U


R
C_p
+
C
L
VD
–


R
VD
+
C
L
VD
–


свет
+
p
–
n
Zn
+
p
N
–
n
+
p

Задание на самоподготовку

- **1. Изучить (Л1) стр. 199-202.**
- **2. Изучить приложение 6 "Сборника описаний лабораторных работ".**
- **3. Изучить (Л9) стр. 23-28.**